



中国科学院科学出版基金资助出版

半导体学报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 22 卷 第 2 期 2001 年 2 月

目 次

研究快报

InGaAs/GaAs 多量子阱 SEED 面阵结构特性与设计	邓 晖 陈弘达 梁 琨 杜 云 唐 君 黄永箴 潘 钟 马晓宇 吴荣汉 王启明 (116)
等边三角形、正方形和平行四边形微光学谐振腔品质因子的比较	黄永箴 国伟华 (120)
抑制 SOI p-MOSFET 中短沟效应的 GeSi 源/漏结构	黄 如 卜伟海 王阳元 (125)
GSMBE 生长 1.84 μ m 波长 InGaAs/InGaAsP 应变量子阱激光器	柏劲松 方祖捷 张云妹 陈高庭 李爱珍 陈建新 (129)
用新型可交联极化聚合物材料制备的脊波导有机光电调制器	杨晓红 杜 云 殷爱民 石志文 吴荣汉 (133)
高性能 70nm CMOS 器件	徐秋霞 钱 鹤 殷华湘 贾 林 季红浩 陈宝钦 朱亚江 刘 明 (139)

研究论文

直接键合硅片界面键合能的理论分析	韩伟华 余金中 王启明 (140)
分子束外延生长 Al 掺杂 n 型 ZnS _{1-x} Te _x 的类 DX 中心	卢励吾 张砚华 K. K. Mak Z. H. Ma J. Wang I. K. Sou Weikun Ge (145)
聚焦离子束刻蚀性能的研究	谢 进 江素华 王家楫 唐雷钧 宗祥福 (151)
薄栅氧化层相关击穿电荷	刘红侠 郝 跃 (156)
在 SiO ₂ 中掺 Al 对 Au/纳米(SiO ₂ /Si/SiO ₂)/p-Si 结构电致发光的影响	王孙涛 陈 源 张伯蕊 乔永萍 秦国刚 马振昌 宗婉华 (161)
MOCVD 生长的 InGaN 合金的性质	闫 华 卢励吾 王占国 (166)
ZnTe:Cu 薄膜的制备及其性能	郑家贵 张静全 蔡 伟 黎 兵 蔡亚平 冯良桓 (171)
Cd _{1-x} Zn _x Te 晶片中 Zn 组分的室温显微光致发光平面扫描表征	李志锋 陆 卫 蔡炜颖 黄根生 杨建荣 何 力 沈学础 (177)
利用高频 Plasma CVD 在蓝宝石衬底上生长立方 GaN 缓冲层及其光学性质	修向前 野崎真次 岛袋淳一 池上隆兴 王大志 汤洪高 (182)
溅射数对 Ge ₂ Sb ₂ Te ₅ 薄膜光学常数的影响	谢 泉 侯立松 阮 昊 干福熹 李 晶 (187)
电化学沉积非晶 NiO _x H _y 膜的电致变色特性及其机理	冯博学 谢 亮 蔡兴民 蒋生蕊 甘润今 (193)
真空蒸镀双层有机电致发光器件及其稳定性	赵俊卿 解士杰 韩圣浩 杨志伟 叶丽娜 杨田林 (198)
Au/PZT/BIT/p-Si 结构铁电存储二极管 I-V 特性	于 军 王 华 董晓敏 周文利 王耘波 郑远开 赵建洪 (203)
一种新的求解 ULSI 双介质互连电容的模拟电荷法	朱兆旻 肖 夏 阮 刚 宋任儒 刘 勇 (208)
一类时序逻辑电路的逻辑参数提取激励波形自动生成	陈水琬 贺祥庆 (214)
风冷热电空调器的研制	张华俊 董晓俊 陶文铨 冯倩莹 邹 挺 (220)
蓝光聚合物单层薄膜发光器件的退化机理	闫金良 朱长纯 (224)
利用 FN 电流估计薄栅 MOS 结构栅氧化层的势垒转变区的宽度	毛凌锋 谭长华 许铭真 (228)
槽栅 NMOSFET 结构与性能仿真	任红霞 郝 跃 许冬岗 (234)
带有发射极边减薄结构的异质结双极晶体管直流电流增益的计算	刘晓伟 张 荣 吴德馨 (241)
高功率密度自对准结构 AlGaAs/GaAs 异质结双极晶体管	严北平 张鹤鸣 戴显英 (247)